Рентгенографические исследования термохромного фазового перехода в кристалле $[NH_2(C_2H_5)_2]_2CuCl_4$

© А.У. Шелег, Е.М. Зуб, А.Я. Ячковский

Объединенный институт физики твердого тела и полупроводников Национальной академии наук Белоруссии, 220072 Минск, Белоруссия

E-mail: sheleg@ifttp.bas-net.by

(Поступила в Редакцию 6 марта 2006 г.)

Проведены рентгенографические исследования параметров элементарной ячейки кристалла $[NH_2(C_2H_5)_2]_2CuCl_4$ и рассчитаны коэффициенты теплового расширения для основных кристаллографических направлений в области температур 100–330 К. Изучено поведение интенсивностей дифракционных рефлексов от кристалллографических плоскостей (100), (010) и (001) при переходе через температуру термохромного фазового перехода. Получены экспериментальные данные, подтверждающие наличие фазового перехода первого рода в кристалле $[NH_2(C_2H_5)_2]_2CuCl_4$ при $T \approx 324$ К.

Работа выполнена в рамках проекта Ф04-005, финансируемого Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований.

PACS: 61.50.Ks, 61.10.Nz, 65.40.De

1. Введение

Кристаллы диэтиламинтетрахлоркупрата $[\mathrm{NH}_2(\mathrm{C}_2\mathrm{H}_5)_2]_2\mathrm{CuCl}_4$ $((ДЭА)_2CuCl_4)$ относятся к семейству А2ВХ4, у многих представителей которого наблюдается последовательность температурных фазовых переходов (ФП). Кристаллы (ДЭА)₂CuCl₄ относятся к органико-неорганическим кристаллам с водородными связями между молекулярными катионами и металл-галогенными комплексами [1]. Кристаллическая структура такого типа кристаллов определяется в основном балансом водородных связей в элементарной ячейке, которые под влиянием внешних воздействий (температура, давление, облучение) трансформируются, что приводит к ее изменению. В кристалле (ДЭА)₂CuCl₄ под воздействием температуры при $T \approx 323 \,\mathrm{K}$ наблюдается термохромный ФП первого рода, в результате которого при росте температуры у кристалла происходит не только изменение цвета с зеленого на желтый, но и трансформация его кристаллической структуры из моноклинной с пространственной группой P21/n в моноклинную с пространственной группой P2₁/c с изменением параметров элементарной ячейки [2]. Параметры элементарной ячейки низкотемпературной фазы при комнатной температуре равны a = 7.362 Å, b = 15.023 Å, c = 45.193 Å, $\beta = 89.94^{\circ}$ и Z = 12, а для высокотемпературной они составляют a = 25.055 Å,b = 10.531 AA, c = 13.455 Å, $\beta = 100.06^{\circ}$ и Z = 8 [2]. Природа термохромного $\Phi\Pi$ в кристалле (ДЭА)₂CuCl₄ исследовалась оптическим [1] и рентгенографическим [2] методами; было показано, что причиной изменения структуры и цвета этого кристалла является изменение плоскоквадратной геометрии координационного окружения иона Cu²⁺ на тетраэдрическую. Изменение геометрии координационного окружения обусловлено большой чувствительностью водородных связей к внешним воздействиям, в данном случае к температуре.

Целью настоящей работы является рентгенографическое исследование температурных зависимостей интегральных интенсивностей дифракционных рефлексов, параметров элементарной ячейки и коэффициентов теплового расширения низкотемпературной фазы кристалла $(ДЭA)_2CuCl_4$ в широкой области температур (и особенно в окрестности термохромного фазового перехода).

2. Методика эксперимента

Кристаллы (ДЭА)₂CuCl₄ выращивались из водного раствора солей CuCl₂· 2H₂O и (C₂H₅)₂NH₂Cl, взятых в стехиометрическом соотношении, методом медленного испарения растворителя при комнатной температуре. В результате в течение трех-четырех недель вырастали кристаллы размером $\sim 10 \times 6 \times 3$ mm.

Рентгенографические измерения параметров элементарной ячейки проводились на дифрактометре TUR-M62 с использованием Си К_а-излучения и низкотемпературной рентгеновской камеры. Измерения проводились в интервале температур 100-330 К. В качестве образцов использовались монокристаллические пластинки размером $\sim 5 \times 4 \times 2$ mm, вырезанные из выращенных кристаллов. Отражающими плоскостями служили естественная грань роста (010), которая выходила на поверхность образцов, и плоскость скола (100). Плоскость (001) выводилась на поверхность образцов рентгенографическим методом с точностью 5-7'. Помещенный в держатель образец перед каждой рентгеносъемкой термостатировался в течение 10-15 min при заданной температуре. Методом непрерывного сканирования по схеме $\theta - 2\theta$ проводилась запись профилей интенсивностей рефлексов на перфоленту через каждые 1-2К со скоростью счетчика 0.25 deg/min. Дифракционные углы определялись по центру тяжести профилей рефлексов 700, 0.14.0 и 0.0.30 с точностью 0.2–0.4'. Температура образца задавалась блоком регулировки, выполненным на основе регулятора температуры. Контроль температуры проводился с помощью медьконстантановой термопары. Эта система позволяла задавать и поддерживать температуру в измеряемой области с точностью ±0.1 К.

3. Результаты исследования и их обсуждение

Значения параметров элементарной ячейки кристалла $(ДЭА)_2 CuCl_4$, определенные нами при комнатной температуре, равны $a = 7.362 \pm 0.005$ Å, $b = 15.025 \pm 0.004$ Å, $c = 45.152 \pm 0.006$ Å, что хорошо согласуется с результатами работы [2].

На рис. 1–3 приведены температурные зависимости параметров элементарной ячейки a(T), b(T) и c(T) и значения коэффициента теплового расширения (КТР) $\alpha_a(T)$, $\alpha_b(T)$ и $\alpha_c(T)$ кристалла $[\mathrm{NH}_2(\mathrm{C}_2\mathrm{H}_5)]_2$. CuCl₄. Как видно из рисунков, параметры a, b и c с ростом температуры плавно увеличиваются. Кривая b(T) не является монотонной, и при приближении к температуре $\Phi\Pi$ $T \approx 324$ К происходит увеличение параметра b. На кривой c(T) в области температур $\sim 265-280$ К наблюдается аномалия в виде плато. По экспериментальным температурным зависимостям параметров элементарной ячейки a(T), b(T) и c(T) определены соответствующие КТР вдоль основных кристаллографических направлений [100], [010] и [001] в исследованном интервале температур.

Для определения значений КТР экспериментальные кривые a(T), b(T) и c(T) были аппроксимированы наиболее подходящими полиномами вида $L = A + \sum_{i}^{n} B_{i}T^{i}$. Аппроксимационные кривые разбивались на температурные отрезки длиной 2–4 K, на которых расчет КТР проводился согласно формуле $\alpha_{K} = \Delta L/(L\Delta T)$, где L = a, b, c в середине отрезка ΔT , для которого



Рис. 1. Температурная зависимость параметра *а* элементарной ячейки кристалла (ДЭА)₂CuCl₄ (1 — эксперимент, 2 — аппроксимация) и КТР α_a (3).



Рис. 2. Температурная зависимость параметра *b* элементарной ячейки кристалла (ДЭА)₂CuCl₄ и КТР α_b . Обозначение кривых то же, что и на рис. 1.



Рис. 3. Температурная зависимость параметра c элементарной ячейки кристалла (ДЭА)₂CuCl₄ и КТР α_c . Обозначение кривых то же, что и на рис. 1.

определялся КТР, ΔL — изменение параметра на этом отрезке.

На рис. 1-3 (штриховые линии) приведены температурные зависимости значений КТР $\alpha_a(T)$, $\alpha_b(T)$ и $\alpha_{c}(T)$ вдоль основных кристаллографических осей. Из рисунков видно, что значения КТР α_a во всем исследуемом интервале температур с ростом температуры увеличиваются по линейному закону. Значения α_h в области температур 100-300 К и α_c в интервале температур 100-250 К практически не изменяются с ростом температуры и только вблизи температуры ФП происходит резкое увеличение КТР α_b , а на кривой $\alpha_c(T)$ при $T \approx 275 \, \text{K}$ наблюдается аномалия в виде минимума. Возможно, эта аномалия обусловлена разупорядочением молекулярных катионов в кристаллической структуре (ДЭА)₂CuCl₄. Из полученных данных видно, что в кристалле (ДЭА)₂CuCl₄ анизотропия теплового расширения отсутствует.

На рис. 4 приведены дифрактограммы кристалла (ДЭА)₂CuCl₄, записанные при различных значениях тем-



Рис. 4. Дифрактограммы, записанные от плоскости (100), при различных температурах кристалла (ДЭА)₂CuCl₄.

пературы образца. Запись проводилась от плоскости скола (100). При температурах $T_1 = 316$ К, $T_2 = 318$ К, $T_3 = 320$ К, $T_4 = 322$ К на дифрактограммах наблюдаются дифракционные рефлексы, характерные для низкотемпературной фазы исследуемого кристалла. С ростом температуры интенсивности всех рефлексов незначительно уменьшаются, и только при $T_4 = 324$ К они исчезают. Запись дифрактограммы при T = 324 К проводилась в режиме максимальной чувствительности измерителя скорости счета импульсов в отличие от дифрактограмм, записанных при более низких температурах.

На рис. 5 приведены температурные зависимости интенсивностей дифракционных рефлексов 300, 050 и 0.0.15 кристалла $(ДЭА)_2CuCl_4$ в интервале ~ 316-324 К в режиме нагревание-охлаждение. Из этого рисунка видно, что с ростом температуры интенсивности всех рефлексов незначительно уменьшаются, при T = 322 К происходит резкое падение интенсивностей, а при T = 324 К они равны нулю. Нагревание образца кристалла $(ДЭА)_2CuCl_4$ до T = 332 К не приводит к появлению дифракционных рефлексов высокотемпературной фазы. При последующем охлаждении начиная с этой температуры рефлексы, соответствующие низкотемпературной фазе, снова появляются только при T > 320 К и по мере уменьшения температуры их интенсивность растет. Однако следует заметить, что величины интенсивностей всех рефлексов в режиме охлаждения значительно меньше, чем при тех же температурах в режиме нагревания. Таким образом, наблюдается гистерезис интегральных интенсивностей дифракционных рефлексов в области температуры ФП. Наличие температурного гистерезиса подтверждает существование ФП первого рода в этом кристалле. Из рис. 5 также видно, что данный ФП является обратимым, т.е. при охлаждении кристалла из области выше температуры ФП низкотемпературная фаза восстанавливается.

Следует отметить, что разупорядочение кристаллической структуры, которое происходит при переходе кристалла в высокотемпературную фазу, при последующем охлаждении полностью не исчезает, поскольку интенсивности дифракционных линий не восстанавливаются до первоначальных значений (рис. 5). Отсутствие



Рис. 5. Температурные зависимости интенсивностей дифракционных рефлексов 300 (*a*), 050 (*b*) и 0.0.15 (*c*) в режиме охлаждения и нагревания в области термохромного $\Phi\Pi$.

дифракционной картины при нагревании образца от 234 до 332 К свидетельствует об отсутствии кристаллической высокотемпературной фазы выше температуры ФП. Таким образом, в процессе нагревания низкотемпературной фазы невозможно получить высокотемпературную кристаллическую фазу. Это утверждение согласуется с результатами работы [2], где показано, что низкотемпературная фаза, нагретая выше температуры ФП, теряет кристалличность. Из рис. 5 следует, что температура ФП равна $T = 324 \, \text{K}$, что хорошо согласуется с результатами работы [3], где при исследовании теплоемкости данного кристалла установлено, что температура ФП этого кристалла T = 323.7 К. Для получения высокотемпературной фазы авторы работы [2] разработали специальную методику, которая состоит в том, чтобы получать высокотемпературную фазу не из раствора, а из расплава (ДЭА)₂CuCl₄ при температуре T > 323 K, т.е. выше температуры термохромного ФП.

4. Заключение

Рентгенографическим методом подтверждено наличие $\Phi\Pi$ первого рода при $T=324\,{
m K}$ в кристалле (ДЭА) $_2{
m CuCl}_4$.

Показано, что в области $\Phi \Pi$ в этом кристалле наблюдается гистерезис интенсивностей брэгговских рефлексов, а сам переход является обратимым.

Установлено, что при нагревании низкотемпературной фазы кристалла $(Д \Im A)_2 CuCl_4$ выше температуры $\Phi \Pi$ исчезает ее кристалличность, т.е. получить высокотемпературную фазу таким способом невозможно.

Список литературы

- [1] В.Б. Капустянык, Ю.М. Корчак. ЖПС 67, 759 (2000).
- [2] D.R. Bloomguist, M.R. Pressprich, R.D. Willet. J. Am. Chem. Soc. 110, 7391 (1988).
- [3] А.У. Шелег, Т.И. Декола, Н.П. Теханович. ФТТ 47, 2050 (2005).